





	<h2 style="color: red;">FQD13N06TM</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FQD13N06TM</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 10A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD13N06TM.pdf 2.FQD13N06TM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 20810 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD13N06TM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 10A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	20810 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 28W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	10A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	140 mOhm @ 5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	310pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQD13N06TM ist neu im Original, Suche FQD13N06TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD13N06TM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD13N06TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD13N10LTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p>	 <p>FQD13N06TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 10A DPAK</p>	 <p>FQD13N06TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 10A DPAK</p>	 <p>FQD13N06LTM-NL FAIRCHILD FQD13N06LTM-NL FAIRCHILD</p>
 <p>FQD13N06TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 10A DPAK</p>	 <p>FQD13N10L F FQD13N10L F</p>	 <p>FQD13N10LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p>	 <p>FQD13N10LTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD12N20	↔ FQD12N20L	⇒ FQD12N20LTF	D FQD12N20LTF	⇒ FQD12N20LTM
⊣ FQD12N20LTM	⊗ FQD12N20TF	D FQD12N20TF	⇒ FQD12N20TM	⇒ FQD12N20TM
⊗ FQD12P10	⊣ FQD12P10TF	⊗ FQD12P10TF	↔ FQD12P10TM	⇒ FQD12P10TM
D FQD13N06	⊗ FQD13N06L	⊣ FQD13N06LTF	⊗ FQD13N06LTF	⇒ FQD13N06LTM
⇒ FQD13N06LTM	↔ FQD13N06LTM-NL	⊗ FQD13N06TF	⊣ FQD13N06TF	⇒ FQD13N06TM
↔ FQD13N10	⇒ FQD13N10L	D FQD13N10LTF	⊗ FQD13N10LTF	⊣ FQD13N10LTM
⊗ FQD13N10LTM	D FQD13N10LTM-NL	⇒ FQD13N10TM	↔ FQD13N10TM	⇒ FQD13N20D
⊣ FQD14N15	⊗ FQD16N15	↔ FQD16N25C	⇒ FQD16N25CTM	⇒ FQD16N25CTM
⊗ FQD16N25L	⊣ FQD17N08	⊗ FQD17N08L	D FQD17N08LTF	⇒ FQD17N08LTF
↔ FQD17N08LTM	⊗ FQD17N08LTM	⊣ FQD17N10	⊗ FQD17P06	⇒ FQD17P06TF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited